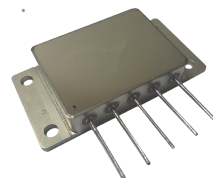




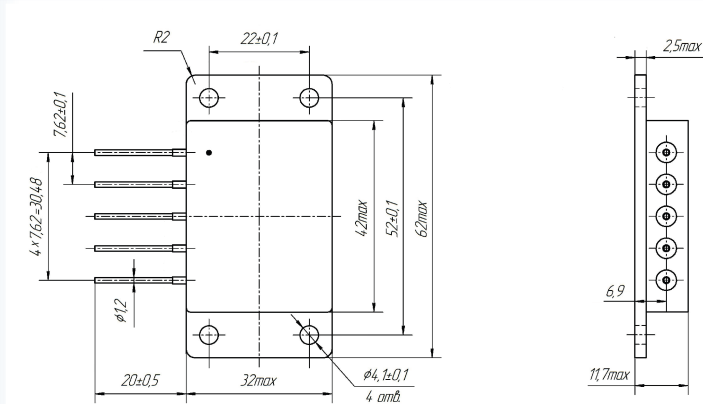
МОДУЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

КМ410А, КМ410Б, КМ410В, КМ410Г

Мощные полупроводниковые модули в металлокерамических корпусах с изолированным фланцем предназначены для использования в системах электроснабжения, в преобразовательной технике и другой аппаратуре широкого применения, изготавливаемой для народного хозяйства.



Масса модуля не более 60 г.



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ ЯАВД.432325.015ГЧ

Модули соответствуют АДКБ.432170.504ТУ.

Таблица 1. Основные электрические параметры при $T = 25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		КМ410А	КМ410Б	КМ410В	КМ410Г
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА	$I_{КЭК}$	≤ 4	≤ 2		
($U_{КЭ} = 1700\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0$)					
($U_{КЭ} = 1200\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0$)				$\leq 1,5$	
Ток утечки затвора ($U_{КЭ} = 0, U_{ЗЭ} = \pm 20\text{ В}$), нА	$I_{з.ут}$	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ.нас}$	$\leq 3,5$		$\leq 2,8$	
($I_{КЭ} = 100\text{ А}, U_{ЗЭ} = 15\text{ В}$)					
($I_{КЭ} = 50\text{ А}, U_{ЗЭ} = 15\text{ В}$)			$\leq 3,5$		$\leq 2,8$
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($I_{К} = 1\text{ мА}$), В	$U_{ЗЭ.пор}$	2,5 – 6,5	2,5 – 6,5	2,5 – 6,5	2,5 – 6,5
Постоянное прямое напряжение диода, В	$U_{ПР}$	$\leq 3,3$		$\leq 2,5$	
($I_{ПР} = 100\text{ А}$)					
($I_{ПР} = 50\text{ А}$)			$\leq 3,3$		$\leq 2,5$
Время включения, нс	$t_{вкл}$	≤ 400	≤ 400		
($U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 900\text{ В}$)					
($U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 600\text{ В}$)			≤ 400	≤ 400	
Время выключения, нс	$t_{выкл}$	≤ 800	≤ 800		
($U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 900\text{ В}$)					
($U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 600\text{ В}$)			≤ 800	≤ 800	
Входная емкость ($U_{КЭ} = 25\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0\text{ В}, f = 1\text{ МГц}$), нФ	$C_{ВХ}(C_{11Э})$	≤ 6	≤ 10	≤ 6	≤ 10
Выходная емкость ($U_{КЭ} = 25\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0\text{ В}, f = 1\text{ МГц}$), нФ	$C_{ВЫХ}(C_{22Э})$	$\leq 0,9$	$\leq 0,5$	$\leq 0,9$	$\leq 0,5$
Время обратного восстановления диода ($U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 900\text{ В}$), нс	$t_{вос.обр}$	≤ 800	≤ 800	≤ 800	≤ 800
Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т П-К}$	$\leq 0,25$	$\leq 0,36$	$\leq 0,25$	$\leq 0,36$

Таблица 2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		КМ410А	КМ410Б	КМ410В	КМ410Г
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{кэ.мах}$	1700	1700	1200	1200
Максимально допустимое напряжение коллектор-затвор, В	$U_{кз.мах}$	1700	1700	1200	1200
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер, В	$U_{зэ.мах}$	± 20	± 20	± 20	± 20
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{к.мах}$	100	50	100	50
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, А	$I_{пр.мах}$	100	50	100	50
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{к(и)мах}$	200	100	200	100
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А	$I_{пр(и)мах}$	200	100	200	100
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность модуля при температуре корпуса от 60 до плюс 25 °С, Вт	$P_{кмах}$	500	350	500	350